

	<p>SI4666DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4666DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4666DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 21779 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4666DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21779 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4666DY-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1145pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 16.5A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.5A (Tc)

SI4666DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4666DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4666DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4666DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4668DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4660DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC</p>	 <p>SI4660DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 23.1A 8-SOIC</p>	 <p>SI4666DY-T1-E3 VISHAY SI4666DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4666DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4668DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4668DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 16.2A 8-SOIC</p>	 <p>SI4662DY-T1-GE3 V SI4662DY-T1-GE3 V</p>

SI4666DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4666DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4666DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4666DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4666DY-T1-GE3
SI4666DY-T1-GE3 Electronic	SI4666DY-T1-GE3-Komponenten	SI4666DY-T1-GE3-Verteiler	SI4666DY-T1-GE3-Bild	SI4666DY-T1-GE3-Teil
SI4666DY-T1-GE3 Preis	SI4666DY-T1-GE3 Hersteller	SI4666DY-T1-GE3 Bild	SI4666DY-T1-GE3 Aktie	SI4666DY-T1-GE3 Inventar
SI4666DY-T1-GE3 Neu	SI4666DY-T1-GE3 Original	SI4666DY-T1-GE3 garantiert	SI4666DY-T1-GE3 RFQ	SI4666DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited